

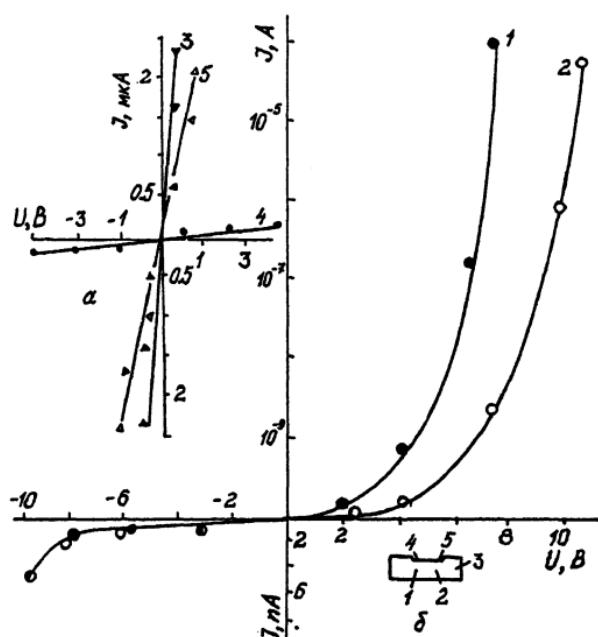
06.1;07;12

© 1994

# ОБРАЗОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ПРОВОДИМОСТИ В CdS ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ДЛИННОВОЛНОВЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

*Д.И. Цюцюра, П.С. Шкумбатюк*

Настоящее сообщение содержит результаты по продолжению исследования влияния термического действия непрерывного  $\text{CO}_2$  лазерного излучения на полупроводниковые соединения  $A_2\text{B}_6$ , рассмотренные в работе [1]. В качестве материала использован нелегированный CdS *n*-типа проводимости. Облучение сколотых поверхностей производилось в нормальных условиях мощностью 100–600 Вт/см<sup>2</sup>. Одним из существенных изменений исходных свойств материала при облучении определенной мощностью и временем облучения является возникновение нелинейной проводимости в облученном материале. В результате измерения элек-



**Рис. 1.** Вольт-амперные характеристики облученного образца измерены на контактах 1 — (1, 4), 2 — (3, 4).

На вставке *a*: ВАХ измерены на контактах 3 — (1, 2), 4 — (4, 5), 5 — исходный образец. Вставка *б* — схема контактных выводов облученного образца: 1, 2 — объемная часть, 4, 5 — приповерхностный слой, 3 — необлученная часть.

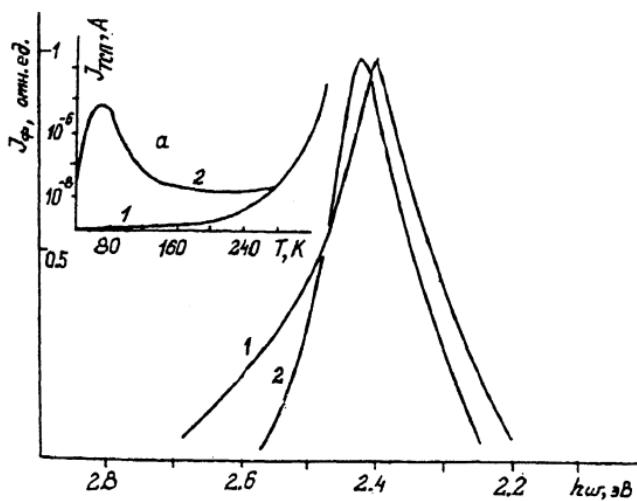


Рис. 2. Спектральная зависимость фотопроводимости облученного образца. 1 — объемная часть (контакты 1, 2), 2 — приповерхностный слой (контакты 4, 5).

На вставке — спектры термостимулированной проводимости.

трических свойств выявлено значительное уменьшение проводимости облученной поверхности и некоторое увеличение проводимости объемной части материала (рис. 1, кривые 3 и 4 на вставке). Выявлено также, что способствованию формирования высокоомного приповерхностного слоя и незначительного изменения объемных свойств материала при облучении существенную роль служат пары компонентов S и Cd и, в некоторой степени, величина проводимости исходного материала. Облучение в вакууме с интенсивной откачкой испаряемых S и Cd с приповерхностной облучаемой областью приводит к менее значительному уменьшению проводимости этого слоя.

Измерение вольт-амперных характеристик между объемной и поверхностной частями облученного материала в прямом и обратном направлениях показали, что в более совершенных структурах коэффициент нелинейности достигает 5–7 порядков (рис. 1, кривые 1, 2). По термоэлектрическим измерениям объемной части облученных образцов установлено, что изменение типа проводимости при облучении не происходит. Тип проводимости высокоомного слоя не установлен. Предполагается, что в связи с соответствием положительного знака напряжения в прямом направлении при измерении вольт-амперных характеристик высокоомный слой обладает р-типа проводимости с небольшой

концентрацией дырок. Подтверждение тому — отсутствие фототока в режиме короткого замыкания в таких структурах. Что касается фотоэлектрических свойств, то в сформированных таким способом структурах наблюдается значительное увеличение фотопроводимости. Для нефоточувствительного материала после лазерного облучения при небольшом обратном напряжении смещение фотоочувствления пропорционально коэффициенту нелинейности.

Исследование фотоэлектрических свойств как приповерхностной, так и объемной части облученного материала показали, что основной вклад в фотоочувствление вносит приповерхностная область. Предполагается, что согласно [2,3], высокоомный слой формируется за счет увеличения концентрации S и уменьшении концентрации Cd из-за более длительного облучения, при этом междуузельные атомы S могут занимать ваканции Cd. Частичное подтверждение тому — смещение максимума фотопроводимости сформированного слоя по отношению к объемной фотопроводимости обученного материала (рис. 2, кривая 2). Увеличение проводимости объемной части обученного материала связано с распадом мелких уровней, что подтверждается спектрами термостимулированной проводимости (рис. 2, а).

Таким образом, термическое воздействие CO<sub>2</sub> лазерного излучения способствует образованию структур с нелинейной проводимостью, что приводит к значительному фотоочувствлению исходного материала. Предполагается, что представленный способ может быть использован для формирования многоэлементных матриц.

#### Список литературы

- [1] Плюцюра Д.И., Шкумбатюк П.С. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 1. С. 12–15.
- [2] Бродин Ю.С., Даудова Н.А., Шаблий И.Ю. // ФТП. 1976. Т. 5. В. 10. С. 625–630.
- [3] Бродин Ю.С., Городецкий И.Я., Шаблий И.Ю., Корсунская Н.Е. // УФЖ. 1979. В. 10. С. 1539–1544.

Дрогобычский государственный  
педагогический институт  
Украина

Поступило в Редакцию  
22 октября 1993 г.